

RFT SY356/05 ... SY356/10

Schnelle Silizium- Gleichrichterdiode im Kunststoffgehäuse

Typ	$U_{RRM}^{1)}$ (V)	$U_{RSM}^{2)}$ (V)	U_R (V)	$I_{F(AV)}^{3)}$ (A)	$I_{FSM}^{4)}$ (A)
SY356/05	50	50	35	1,5 bis 1,1	80
1	100	100	70		
2	200	200	140		
4	400	400	280		
6	600	600	420		
8	800	800	560		
10	1000	1000	700		

Empfohlene $U_{RWM} \leq 0,7 \times U_{RRM}$
 Sperrschichttemperatur = -40 bis 150°C
 Sperrerrholungszeit $t_{rr} \leq 0,3\mu\text{S}$ Gruppe K
 0,4 μS Gruppe L

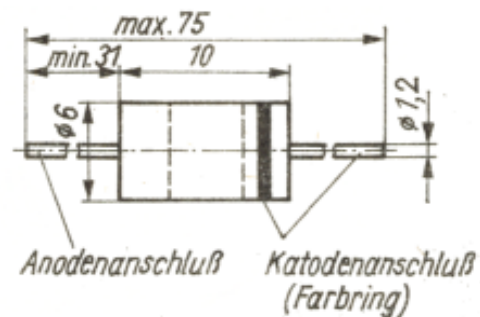
für $I_F = 1\text{A}$,
 $d_{iF}/dt = -25\text{A}/\mu\text{S}$,
 $I_R = 0,5\text{A}$, $\vartheta_j = 25^\circ\text{C}$

¹⁾ t_p/T von $U_R \leq 0,5$, $f = 50\text{Hz} \dots 30\text{kHz}$

²⁾ $t_p \leq 20\text{mS}$

³⁾ Sinushalbwellen, volle Drahtlänge auf Leiterplatte $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}$

⁴⁾ Sinushalbwellen, $f \geq 50\text{Hz}$, $\vartheta_j = 125^\circ\text{C}$, $U_R = 0$



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985

Datasheet Rev. 1.3 – 04/19 – data without warranty / liability